

Germanium PNP Transistor

AD162

32V / 1A

DATASHEET

OEM – Telefunken

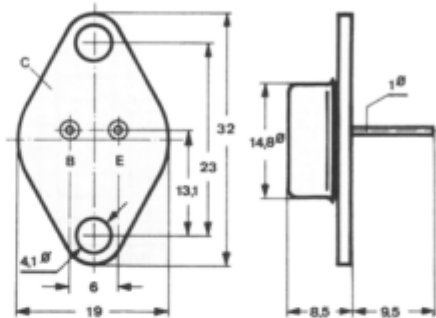
Source: Telefunken Databook 1972/73

AD 162**Germanium-PNP-Transistor für NF-Endstufen, komplementär zu AD 161.**

Germanium PNP transistor for AF power stages, complementary to AD 161.

Abmessungen · Dimensions

Maße in mm
M 1:1

**Zubehör · Accessories**

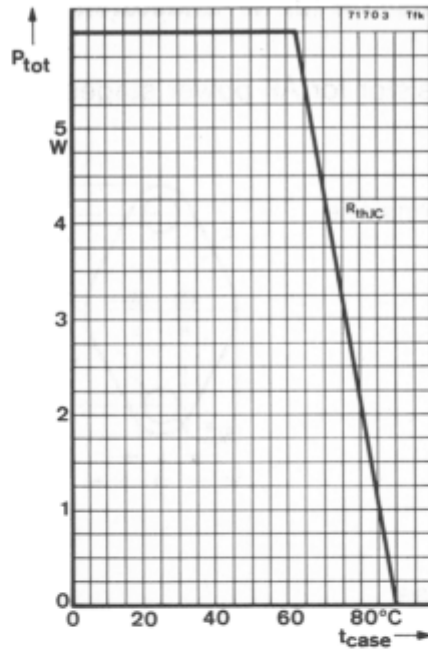
2×Isolierbuchse Best.-Nr. 009 005
2×Isolierbuchse Best.-Nr. 009 013
Isolierscheibe Best.-Nr. 009 014

Normgehäuse
DIN 9 A 2
SOT 9
Gewicht · Weight
max. 10 g

Absolute Grenzdaten · Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung	$-U_{CBO}$	32	V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	$-U_{CEO}$	20	V
Emitter-Basis-Sperrspannung	$-U_{EBO}$	10	V
Kollektorstrom	$-I_C$	1	A
Kollektorspitzenstrom	$-I_{CM}$	3	A
Gesamtverlustleistung $t_{case} \leq 63^\circ C$	P_{tot}	6	W
Sperrschichttemperatur	t_j	90	$^\circ C$
Lagerungstemperatur	t_{stg}	-55...+90	$^\circ C$

AD 162



Min. Typ. Max.

Wärmewiderstand · Thermal resistance

Sperrschicht-Gehäuse	R_{thJC}	4,5 °C/W
----------------------	------------	----------

Kenngößen · Characteristics

Umgebungstemperatur $t_{amb} = 25$ °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorruhestrom		
$-U_{CB} = 20$ V	$-I_{CBO}$	40 μ A
$-U_{CB} = 32$ V	$-I_{CBO}$	200 μ A
Emitterruhestrom		
$-U_{EB} = 10$ V	$-I_{EBO}$	200 μ A
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung		
$-I_C = 3$ A	$-U_{(BR)CEO}^{1)}$	20 V
Kollektor-Sättigungsspannung		
$-I_C = 1$ A ($-U_{CE} = 1$ V, $-I_C = 1,1$ A)	$-U_{CEsat}^{1) 2)}$	600 mV

1) $t_p = 0,01$, $t_p = 0,3$ ms

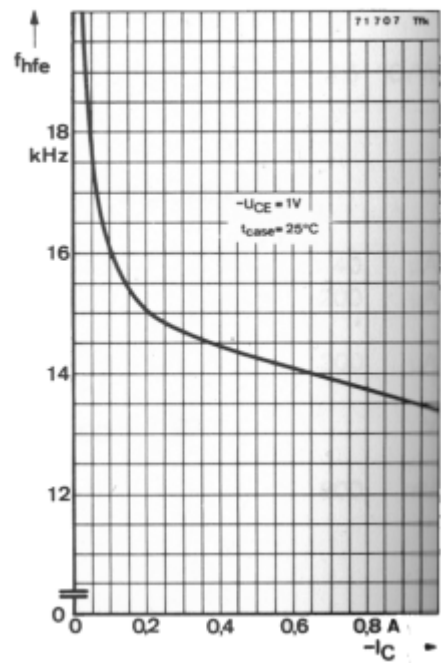
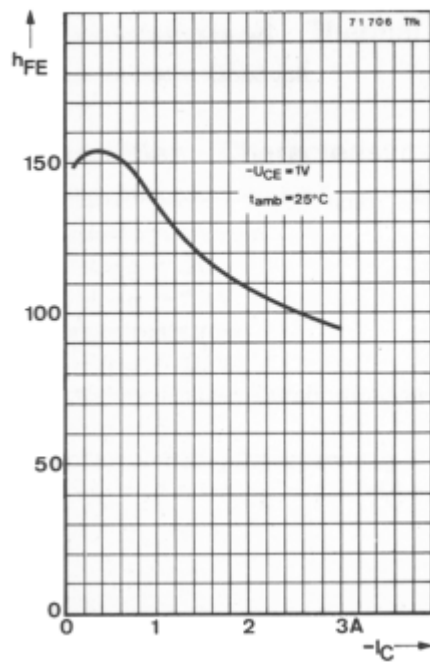
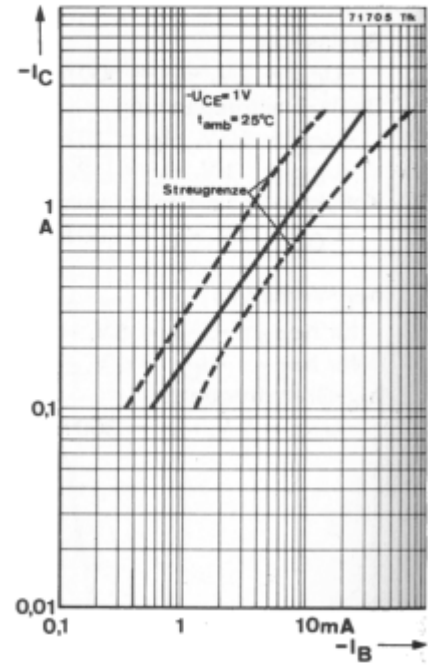
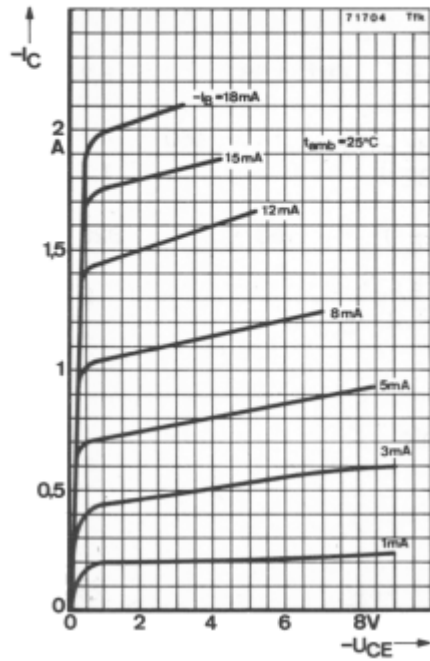
2) siehe Seite A 67
see page

AD 162

		Min.	Typ.	Max.
Basisstrom				
-U _{CE} = 1 V, -I _C = 500 mA	-I _B ¹⁾	1,56		6,2 mA
Basis-Emitterspannung				
-U _{CE} = 10 V, -I _C = 10 mA	-U _{BE}		160	mV
-U _{CE} = 1 V, -I _C = 2 A	-U _{BE} ¹⁾			1,1 V
Kollektor-Basis-Gleichstromverhältnis				
-U _{CE} = 1 V, -I _C = 500 mA	h _{FE} ¹⁾	80		320
h _{FE} -Verhältnis				
für h _{FE} 1: -U _{CE} = 6 V, -I _C = 200 mA	$\frac{h_{FE1}}{h_{FE2}}$ ¹⁾			2
für h _{FE} 2: -U _{CE} = 2 V, -I _C = 2 A	h _{FE} 2			
h _{fe} -Grenzfrequenz				
-U _{CE} = 2 V, -I _C = 300 mA, t _{case} = 25°C	f _{hfe}		15	kHz

¹⁾ $\frac{t_p}{T} = 0,01$, t_p = 0,3 ms

AD 162



AD 162

